К.М. Жидель¹, А.В. Павленко^{1,2} (¹Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия ²Южный научный центр РАН, Ростов-на-Дону, Россия)

АНАЛИЗ ОПТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ТОНКИХ ПЛЕНОК НИОБАТОВ БАРИЯ-СТРОНЦИЯ СОСТАВА SBN-61

Стремительное развитие микро- и наноэлектроники привело к возрастающей роли планарных технологий в современном материаловедении. Так, возрос интерес к вопросам получения и исследования свойств тонкослойных гетероструктур на основе сегнетоэлектрических материалов [1], в частности, ниобатов бариястронция $Sr_{1-x}Ba_xNb_2O_6$. Очевидно, что свойствами пленок можно управлять не только изменением состава, но и технологией получения, выбором кристаллографической ориентации и типом подложек.

В настоящей работе представлены результаты спектрофотометрических и эллипсометрических исследований тонких пленок разной толщины ниобатов бария-стронция Sr_{0,61}Ba_{0,39}Nb₂O₆ (SBN-61), нанесенных на кристаллические подложки MgO (001).

Для определения оптических параметров прозрачных пленок, таких как толщина, показатель преломления и его дисперсия, спектры оптического пропускания. используются Однако ЭТИ измерения не дают полной информации о характере и толщине поверхностного нарушенного слоя или о пограничных слоях. Более толщина пленки менее четверти того. если длины волны зондирующего излучения, то количественная интерпретация спектров становится невозможной. В общем случае информация об оптических свойствах пленки может быть получена из эллипсометрических [2], несмотря трудностей, связанных измерений на ряд С интерпретацией результатов.

Объекты. Методы получения и исследования. Пленки SBN-61 выращены методом газоразрядного ВЧ-катодного распыления керамической мишени стехиометрического состава $Sr_{0,61}Ba_{0,39}Nb_2O_6$ на предварительно подготовленные под гетероэпитаксиальное осаждение монокристаллические подложки MgO (001). Время напыления SBN-61 на MgO составило 5 мин, 10 мин и 115 мин. Эллипсометрические измерения выполнялись с помощью многоуглового отражательного нуль-эллипсометра на длине волны He-Ne лазера $\lambda = 633$ нм. Эллипсометрические углы ψ и Δ рассчитывались по измеряемым азимутам поляризатора входного плеча эллипсометра и анализатора

67

выходного. Спектры оптического пропускания гетероструктур снимались в диапазоне длин волн 200-1000 нм на спектрофотометре Shimadzu UV-2450 при комнатной температуре.

В кристаллах ниобатов бария-стронция рассматриваемого состава $n_0 = 2.3$ и $n_e = 2.28$ [3]. В нулевом приближении изотропной модели ϕ_0 = arctg $n_0 = 66.5^\circ$. Таким образом, обработку результатов эллипсометрических измерений пленок SBN, преимущественно ориентированных в направлении оси *c*, можно выполнять с использованием изотропной модели пленки, принимая $n = n_0$.

Результаты и обсуждение. Эллипсометрические измерения показали, что все исследованные SBN-пленки характеризуются естественным направлением роста, которое совпадает с направлением оптической оси c кристалла (поворот плоскости падения зондирующего луча не приводит к изменению значений ψ и Δ).

На рис. 1 представлены спектры оптического пропускания тонких пленок SBN-61, которые демонстрируют: невозможность определения параметров ДВУХ сверхтонких пленок SBN-61 спектрометрическим методом, т.к. их толщина меньше чем λ/4; возможность определения порядка интерференции на длине волны (m = 2).Поэтому обработке $\lambda = 633 \text{ HM}$ при результатов эллипсометрических измерений для пленок 1 и 2 принималось m = 0, а для пленки 3 m = 2.



Рис. 1. Спектры пропускания пленок: 5 (1), 10 (2), 115 (3) мин.

Для всех пленок зарегистрировано отсутствие пограничных слоев; определены параметры нарушенных поверхностных слоев (табл. 1) – их толщина и эффективные показатели преломления $n_{\rm ef}$, а также соответствующие коэффициенты объемного заполнения q.

№ образца	Пленка	Подложка	Время напыления <i>t</i> , min	Толщина базового слоя d, nm	Показатель преломления $n = n_0$	Толщина нарушенного слоя <i>d</i> ₁ , nm	Коэффициент объемного заполнения q
1	SBN- 61	MgO (001)	5	29	2.3	5	0.6
2			10	42	2.3	5	0.6
3			115	615	2.31	8	0.45

Таблица 1 – Оптические параметры пленок

Характерные расчетные зависимости эллипсометрических углов от угла падения зондирующего луча, а также экспериментальные точки для тонкой (2) из SBN-пленок показаны на рис. 2. Рисунок демонстрирует неплохое согласие эксперимента с теорией, подтверждающее адекватность принятой модели реальным пленкам.



Рис. 2. $\Psi, \Delta(\phi)$ для пленки 2 (t = 10 мин).

Как видно из таблицы, показатели преломления и профили всех пленок практически не отличаются. При этом наблюдается некоторое увеличение толщины поверхностного нарушенного слоя. Особый интерес в полученных результатах представляет рост толщины поверхностного нарушенного слоя с одновременным уменьшением коэффициента объемного заполнения по мере увеличения времени напыления, что обусловлено, с нашей точки зрения, особенностью роста пленок.

Выводы.

Тонкие пленки SBN-61 / MgO (001) независимо от толщины эпитаксиальные с преимущественным направлением роста, параллельным оси с монокристалла. Определены параметры пленок разной толщины – показатель преломления, толщина базового и поверхностного нарушенного слоев, коэффициент объемного заполнения материалом нарушенного слоя. Установлено отсутствие слоя на границе пленка-подложка. Обнаружено, что толщина нарушенного слоя растет, а коэффициент объемного заполнения уменьшается с увеличением толщины пленок. Наблюдается тенденция к росту показателя преломления с приближением его значения к максимальному в объемном материале для данного состава по мере увеличения толщины пленки.

Благодарности.

Авторы выражают благодарность к.ф.-м.н. Кара-Мурза С.В. за помощь в интерпретации данных спектрофотометрических и эллипсометрических измерений.

Использовано оборудование ЦКП «Объединенный центр научно-технологического оборудования ЮНЦ РАН (исследование, разработка, апробация)».

Финансирование.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ (Государственное задание в сфере научной деятельности научный проект № (0852-2020-0032)/(БАЗ0110/20-3-07ИФ)).

ЛИТЕРАТУРА

1. Интегрированные сегнетоэлектрические устройства / К.А. Воротилов, В.М. Мухортов, А.С. Сигов. М.: Энергоатомиздат, 2011. 175 с.

2. Основы эллипсометрии / А.В. Ржанов [и др.]. Новосибирск: Наука, 1978. 424 с.

3. Refractive indices of $Ba_{0,61}Sr_{0,39}Nb_2O_6$ single crystals / D. Kip [et al.] //Physic Status Solidy (a). - 1996. - V. 154. - P. K5-K7.